

# 粉体用ALD装置のご紹介 “Tiビーズへの成膜”

2016年10月27日

(株)菅製作所

## ▽ TiビーズへのAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>成膜結果

### 成膜条件

使用装置:SAL1000B

基板回転:On

振動:On

装置角度:約8度

基板温度:350℃

試料:Φ300um Tiビーズ

H<sub>2</sub>O開時間:15msec

H<sub>2</sub>O後Wait時間:15sec

TMA開時間:15msec

TMA後Wait時間:10sec

繰返し回数:1150cycle



SAL1000B 粉体用ALD装置



成膜前



成膜後  
(色から膜厚200nm程度と推定)

## ▽ TiビーズへのAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>成膜結果(EDS Mapping)

JED-2200 測定結果  
IFD 0000 ハザード

